

InGaAs фотодиод 1654 нм, 300 мкм, SMD — техническое описание

P/N : WIS3-300A

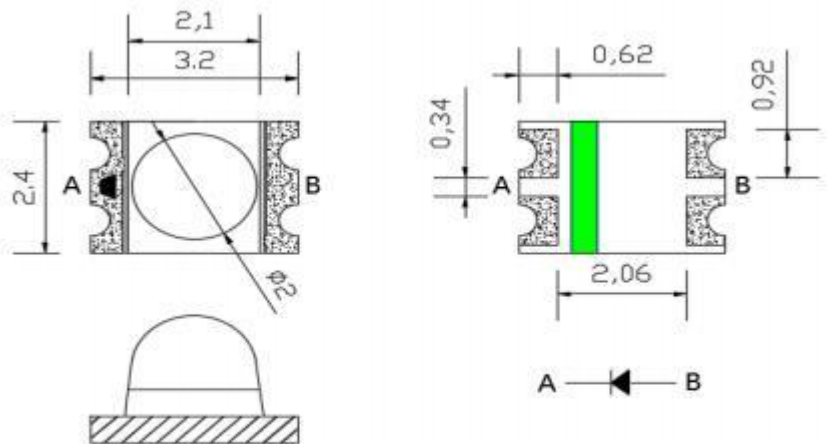
C/N: WIR3-300L

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая чувствительность
- Низкий темновой ток
- Удобен для автоматизированного монтажа

ПРИМЕНЕНИЕ

Датчики СН4



Электрооптические характеристики (T=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	D	-	295	300	305	мкм
Спектральная чувствительность	λ	-	900	1650	1740	нм
Темновой ток	I_d	$V_R = -10V$	-	-	1	нА
Чувствительность	R	$\lambda = 1653nm$	0.9	0.95		А/Вт
Напряжение обратного смещения	V_{br}	$I_r = -1\mu A$	30	40	-	В
Емкость	C	$V_R = -3V, 1MHz$	-	3	5	пФ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Ед. изм.
Рабочая температура	T_{op}	-10	60	°C
Температура хранения	T_{stg}	-40	125	°C
Прямой ток	I_f	-	10	мА